

IX Российская конференция по физике полупроводников

28 сентября – 3 октября 2009, Новосибирск-Томск

Программа

Веб-сайт конференции: http://lib.isp.nsc.ru/semi_2009/index.php

Председатель конференции

А.Л.Асеев СО РАН, ИФП СО РАН

Программный комитет конференции*Председатель*

И.В.Кукушкин ИФТТ РАН, Черноголовка

Ученый секретарь

И.П.Акимченко ОФН РАН, Москва

Члены программного комитета:

Ж.И. Алферов	С.-Пт. ФТ НОЦ РАН, С.-Петербург	Ю.Г. Кусраев	ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург
А.А. Андронов	ИФМ РАН, Н. Новгород	М.Г.Мильвидский	ГИРЕДМЕТ, Москва
А.Л. Асеев	ИФП СО РАН, Новосибирск	И.Г. Неизвестный	ИФП СО РАН, Новосибирск
В.А. Волков	ИРЭ РАН, Москва	В.И. Окулов	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
С.В. Гапонов	ИФМ РАН, Н. Новгород	А.А. Орликовский	ФТИ РАН, Москва
А.А. Гиппиус	ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва	Я.Е. Покровский	ИРЭ РАН, Москва
А.В. Двуреченский	ИФП СО РАН, Новосибирск	S.J. Pearton	University of Florida, Gainesville, USA
В.С. Днепровский	МГУ, Москва	А.А. Саранин	ИАПУ ДВО РАН, Владивосток
А.Г. Забродский	ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург	Н.Н. Сибельдин	ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва
С.В. Зайцев-Зотов	ИРЭ РАН, Москва	Р.А. Сурис	ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург
В.В. Кведер	ИФТТ РАН, Черноголовка	P. Siffert	EMRS, Strassbourg, France
Л.В. Келдыш	ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва	А.С. Терехов	ИФП СО РАН, Новосибирск
Н.Г.Колин	ГНЦ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Обнинск	В.Б. Тимофеев	ИФТТ РАН, Черноголовка
Ю.В. Копаев	ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва	В.В. Устинов	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
П.С. Копьев	ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург	Д.Р. Хохлов	МГУ, Москва
З.Ф. Красильник	ИФМ РАН, Н. Новгород	А.В. Чаплик	ИФП СО РАН, Новосибирск
Г.Я. Красников	ОАО «НИИМЭ и Микрон», Москва	В.И. Шашкин	ИФМ РАН, Н. Новгород
Ф.А. Кузнецов	ИНХ СО РАН, Новосибирск		
В.Д. Кулаковский	ИФТТ РАН, Черноголовка		

Организационный комитет конференции

Председатель

А.В.Двуреченский ИФП СО РАН, Новосибирск

Заместители председателя

Г.В.Майер ТГУ, Томск

С.Г.Псахье ИФПМ СО РАН, Томск

Ученый секретарь

Л.А.Ильина ИФП СО РАН, Новосибирск

Члены организационного комитета:

В.Н.Брудный	ТГУ, Томск	Ф.А.Кузнецов	ИНХ СО РАН, Новосибирск
П.Т.Девяткин	ИФП СО РАН, Новосибирск	О.В. Лапидус	МНТЦ, Москва
В.В.Емцев	ФТИ им.А.Ф.Иоффе, С.-Петербург	А.В.Латышев	ИФП СО РАН, Новосибирск
К.С.Журавлев	ИФП СО РАН, Новосибирск	В.И. Окулов	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
И.В.Ивонин	ТГУ, Томск	А.В. Панин	ИФПМ СО РАН, Томск
А.П.Казак	ФГУП «НПП «Восток»	В.Я.Принц	ИФП СО РАН, Новосибирск
А.А.Карпушин	Президиум СО РАН, Новосибирск	А.Г.Погосов	ИФП СО РАН, Новосибирск
А.Э.Климов	ИФП СО РАН, Новосибирск	О.П.Пчеляков	ИФП СО РАН, Новосибирск
П.С.Копьев	ФТИ им.А.Ф.Иоффе, С.-Петербург	Н.Н. Сибельдин	ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва
З.Ф.Красильник	ИФМ РАН, Н. Новгород	Ю.Г.Сидоров	ИФП СО РАН, Новосибирск
Г.Л.Курышев	ИФП СО РАН, Новосибирск	Э.В.Скубневский	ИФП СО РАН, Новосибирск

Понедельник, 28 сентября

Пленарное заседание

10:00-10:55, Большой зал Дом Ученых, Новосибирск (Н1)

А.Л.Асеев

Вступительное слово

Пленарный доклад

1

Ю.Г.Кусраев

Спиновые явления в полупроводниках и спинтроника

Секция 1	Секция 2
Спиновые явления, спинтроника, наномagnetизм	Поверхность, пленки, слои
11:00-13:10, Большой зал Дом Ученых, Новосибирск (Н1)	11:00-13:10, Малый зал Дом Ученых, Новосибирск (Н2)
<p>Приглашенные доклады</p> <p>7.1 В.К.Калевич Гигантская спиновая поляризация электронов в полупроводниках при комнатной температуре</p> <p>7.2 Д.Р.Яковлев Когерентная спиновая динамика заряженных квантовых точек</p> <p>7.3 В.В.Бельков, С.Д.Ганичев, С.А.Тарасенко, Д.Р.Яковлев Спиновые токи в полумагнитных гетероструктурах</p> <p>7.4 А.А.Максимов, И.И.Тартаковский, J. Debus, D.R. Yakovlev Спиновая диффузия по системе ионов Mn в гетеромагнитных наноструктурах на основе II-VI полумагнитных полупроводников</p> <p>7.5 Г.В.Астахов, К.В.Кавокин, Ю.Г.Кусраев, Christian Kehl, Jean Geurts, Wolfgang Ossau, T. Wojtowicz, G. Karczewski Динамика связанной спиновой системы магнитных ионов и двумерных дырок вблизи ферромагнитного фазового перехода в квантовых ямах CdMnTe</p>	<p>Приглашенные доклады</p> <p>2.1 Т.И.Батурина Переход в сверхдиэлектрическое состояние в критически разупорядоченных плёнках TiN</p> <p>2.2 А.Г.Журавлев, К.В.Торопецкий, О.Е.Терещенко, В.Л.Альперович Атомные реконструкции и электронные свойства атомно-гладкой поверхности GaAs с адсорбатами</p> <p>2.3 А.А.Саранин, Д.В.Грузнев, А.В.Зотов Динамика атомов на поверхности с квазипериодическим рельефом: атомы Ge на Si(111)'5×5'-Cu</p> <p>2.4 А.В.Васев, М.А.Путято, В.В.Преображенский Роль реконструкционного состояния ростовой поверхности в эпитаксии структурно совершенных слоев GaAs(001)</p> <p>2.5 Ж.В.Смагина, В.А.Зиновьев, В.А.Армбристер, А.В.Ненашев, С.А.Тийс, А.В.Двуреченский Самоорганизация nanoостровков Ge на Si(100) при облучении низкоэнергетическими ионами в процессе эпитаксии</p>
13:10-14:30 Обед	

Секция 1	Секция 2
Двумерные системы	Примеси и дефекты
14:30-16:00, Большой зал Дом Ученых, Новосибирск (Н1)	14:30-16:00, Малый зал Дом Ученых, Новосибирск (Н2)
<p>Приглашенные доклады</p> <p>4.1 С.А.Тарасенко Фотогальванические эффекты в двумерных системах на поверхности кремния</p> <p>4.2 Л.В.Кулик Исследование магнитных фазовых переходов в двумерной электронной системе методом неупругого рассеяния света</p> <p>4.3 В.Т.Долгополов Термодинамические измерения на электронных системах с сильным взаимодействием</p>	<p>Приглашенные доклады</p> <p>8.1 И.П.Звягин Влияние микро- и наноструктуры на прыжковый перенос в неупорядоченных полупроводниках</p> <p>8.2 Г.Ю.Сидоров, Ю.Г.Сидоров, В.С.Варавин Гидрогенизация пленок $Cd_xHg_{1-x}Te$ при химических обработках</p> <p>8.3 Б.Г.Захаров, О.П.Пчеляков, Ю.А.Серебряков, В.И.Стрелов, И.А.Прохоров, А.В.Колесников, М.А.Путятю, Н.А.Паханов, Е.М.Труханов Получение и использование кристаллов и эпитаксиальных гетеросистем на основе GaSb для создания высокоэффективных термофотоэлектрических преобразователей энергии</p>
16:00 – 16:15 Перерыв	

Стендовая сессия 1

16:15-18:15, Второй этаже в холле перед Большим залом Дома Ученых СО РАН, Новосибирск

Объемные полупроводники

- 1.6 А.И.Вейнгер, А.Г.Забродский, **Т.В.Тиснек**, С.И.Голощапов
Угловые зависимости СВЧ магнитосопротивления p-Ge при низких температурах и проблема усреднения эффективной массы дырок
- 1.7 **С.Ю.Саркисов**, М.М.Назаров, О.П.Толбанов, А.П.Шкуринов
Генерация и детектирование импульсного терагерцового излучения в кристаллах GaSe, GaSe_{1-x}Te_x и GaSe_{1-x}S_x
- 1.8 **В.Е.Архинчев**
Прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка в системах конечных размеров
- 1.9 А.Ф.Орлов, Л.А.Балагуров, **И.В.Кулеманов**, Ю.Н.Пархоменко, А.В.Картавых, В.В.Сарайкин, В.И.Зиненко
Компенсация носителей заряда в ферромагнитном кремнии, имплантированном марганцем

Поверхность, пленки, слои

- 2.11 А.Г.Настовьяк, И.Г.Неизвестный, **Н.Л.Шварц**
Влияние условий роста на морфологию нановискеров (Монте-Карло моделирование)
- 2.12 В.И.Козловский, **Д.Е.Свиридов**, Д.А.Санников
Исследование сколов наноразмерной гетероструктуры CdS/ZnSSe методом сканирующей микроскопии сопротивления растекания
- 2.13 **С.А.Тийс**, Р.А.Жачук, Б.З.Ольшанецкий
Исследование методом СТМ поверхностных структур Sr на Si(111)
- 2.14 **Ю.Г.Галицын**, А.А.Лямкина, С.П.Мощенко, А.И.Торопов
Статистическое рассмотрение образования самоорганизованного ансамбля квантовых точек InAs на (001)GaAs
- 2.15 **А.В.Войцеховский**, С.Н.Несмелов, С.М.Дзядух, В.С.Варавин, С.А.Дворецкий, Н.Н.Михайлов, Ю.Г.Сидоров, М.В.Якушев
Вольт-фарадные характеристики МДП-структур на основе варизонного МЛЭ Hg_{1-x}Cd_xTe при пассивации эпитаксиально выращенным in situ CdTe
- 2.16 **В.А.Швец**, М.В.Якушев, И.А.Азаров, Е.В.Спесивцев, С.В.Рыхлицкий, Ю.Г.Сидоров
Эллипсометрическая in situ методика контроля состава слоев CdZnTe при их эпитаксиальном выращивании методом МЛЭ

- 2.17 **П.Л.Новиков**, С.Бинетти, А.Ле Донне, Ф.Монталенти
Механизм формирования нанокристаллов в пленках Si при плазмо-химическом осаждении
- 2.18 **М.В.Якушев**, Д.В.Брунев, К.Н.Романюк, А.Е.Долбак, А.С.Дерябин, Ю.Г.Сидоров
Морфология поверхности подложки Si(310), используемой для молекулярно лучевой эпитаксии CdHgTe
- 2.19 **Н.Н.Михайлов**, С.А.Дворецкий, В.А.Швец, С.Д.Ганичев, З.Д.Квон
Контролируемое выращивание одиночных и множественных Cd_xHg_{1-x}Te/HgTe/Cd_xHg_{1-x}Te квантовых ям
- 2.20 **И.В.Ивонин**, И.А.Бобровникова
Микрорельеф поверхности и элементарные процессы роста при эпитаксии полупроводников A₃B₅
- 2.21 **Г.А.Качурин**, В.А.Скуратов, С.Г.Черкова, Д.В.Марин, А.Г.Черков
Формирование квантово-размерных нанокристаллов Si в слоях SiO₂ при облучении тяжелыми ионами высоких энергий
- 2.22 **О.Е.Терещенко**, К.В.Торопецкий, С.В.Еремеев, С.Е.Кулькова
Новые Ga-обогащенные реконструкции на поверхности GaAs(001)
- 2.23 **М.А.Путято**, В.В.Преображенский, Б.Р.Семягин, Ю.Б.Болховитянов
МЛЭ GaP на Si(001): влияние условий зарождения слоя GaP на его полярность
- 2.24 **А.С.Дерябин**, Л.В.Соколов, Е.Е.Родякина
Индукцированная С самоорганизация островков Ge при МЛЭ Ge/CaF₂/Si(111)
- 2.25 В.Н.Неведомский, Н.А.Берт, **В.В.Чалдышев**, В.В.Преображенский, М.А.Путято, Б.Р.Семягин
Самоорганизация полупроводниковых InAs и полуметаллических As квантовых точек в едином процессе молекулярно-лучевой эпитаксии GaAs
- 2.26 **Л.В.Арапкина**, В.А.Юрьев, В.М.Шевлюга
Структура поверхности Si(001) с реконструкцией c(8×n)

Гетероструктуры и сверхрешетки

- 3.8 О.А.Шегай, В.И.Машанов, А.И.Никифоров, В.В.Ульянов, О.П.Пчеляков
Фотопроводимость Si/Ge/Si структур с целым и полуцелым числом монослоев Ge
- 3.9 **В.В.Белых**, М.Х.Нгуен, Н.Н.Сибельдин, М.Л.Скориков, В.А.Цветков
Динамика перехода от режима слабой связи к режиму сильной связи в системе экситонных поляритонов в полупроводниковых микрорезонаторах
- 3.10 Ю.Г.Пейсахович, **А.А.Штыгашев**
Осцилляции тока при фотоэмиссии из двойной квантовой ямы

- 3.11 **А.Я.Шульман**
Туннельный гамильтониан – строгий вывод

Двумерные системы

- 4.19 **А.А.Грешнов**, Г.Г.Зегря, Э.Н.Колесникова
Релевантные квантовые поправки к проводимости в магнитном поле: баллистические диффузоры и квантовый эффект Холла
- 4.20 М.В.Якунин, С.М.Подгорных, Н.Н.Михайлов, **С.А.Дворецкий**
Спиновые расщепления в квантовой яме n-HgTe/Cd_xHg_{1-x}Te с инвертированным зонным спектром
- 4.21 **В.Шикин**, С.Назин
Двухкомпонентная холловская гидродинамика в 2Д проводящих системах
- 4.22 **А.В.Иконников**, В.Я.Алешкин, В.И.Гавриленко, Б.Н.Звонков, Д.В.Козлов, К.В.Маремьянин, О.Драченко, Mi.Goiran, Je.Leotin, Mi.Orlita, Jo.Wosnitza, Ma.Helm
Проявления эффектов обменного взаимодействия в циклотронном резонансе двумерных электронов и дырок
- 4.23 **И.Л.Дричко**, И.Ю.Смирнов, А.В.Суслов, О.А.Мионов
Гигантское положительное магнетосопротивление в p-Si/SiGe/Si квантовой яме в параллельном магнитном поле
- 4.24 **Э.Г.Батыев**
Сверхпроводящее состояние экситонного диэлектрика
- 4.25 **А.А.Шерстобитов**, Г.М.Миньков, А.В.Германенко, О.Э.Рут, И.В.Солдатов, Б.Н.Звонков
Экспериментальное исследование пространственного распределение электронного газа в сильнонеупорядоченных двумерных системах
- 4.26 **Г.М.Миньков**, А.А.Шерстобитов, В.А.Ткаченко, О.А.Ткаченко
Переход к перколяции и прыжковой проводимости в структурах с двумерным разупорядоченным массивом антиточек
- 4.27 **В.М.Эдельштейн**
Возбуждение парамагнитного резонанса в двумерных асимметричных полупроводниковых структурах электрическим полем
- 4.28 **И.С.Бурмистров**, Н.М.Щелкачев
Электронные свойства двумерной неупорядоченной электронной жидкости: роль спиновых и долинных степеней свободы
- 4.29 **В.Г.Попов**, S.Wiedmann, J.-C.Portal
Температурная зависимость спектров резонансного туннелирования электронов между двумерными электронными газами в квантовых магнитных полях

- 4.30 **Д.А.Козлов**, З.Д.Квон, А.Е.Плотников
Квазиклассический и квантовый транспорт в двумерном электронном газе с решеткой антиточек, имеющих резкие границы
-
- 4.31 И.В.Андреев, **В.М.Муравьев**, И.В.Кукушкин
Бесконтактное измерение проводимости двумерных электронов в режиме гигантских осцилляций магнитосопротивления, индуцированных микроволновым излучением
-
- 4.32 **А.В.Германенко**, N.Kozlova, Г.М.Миньков, О.Э.Рут, А.А.Щерстобитов, J.Freudenberger
Определение величины эффективного g-фактора двумерного электронного газа с низкой подвижностью
-
- 4.33 **Р.З.Витлина**, Л.И.Магарилл, А.В.Чаплик
2D плазмоны в магнитном поле в системах со спин-орбитальным взаимодействием (SOB)
-
- 4.34 **И.В.Рожанский**, М.Б.Лифшиц, С.А.Тарасенко, Н.С.Аверкиев
Переключение локализованных двумерных состояний акустическим солитоном
-
- 4.35 **Е.Л.Шангина**, К.В.Смирнов, В.В.Ковалюк, Г.Н.Гольцман, А.А.Веревкин, Д.В.Морозов, А.И.Торопов
Предельное время релаксации в полупроводниковых приборах на эффекте разогрева двумерного газа
-
- 4.36 **В.Е.Бисти**
Взаимодействие межподзонных и плазменных возбуждений в двойных асимметричных электронных слоях
-
- 4.37 **М.В.Буданцев**, А.Г.Погосов, А.Е.Плотников, А.К.Бакаров, А. И. Торопов, J.C.Portal
Исследование неравновесного состояния двумерного электронного газа в режиме целочисленного квантового эффекта Холла в наклонных магнитных полях
-
- 4.38 **И.Н.Котельников**, С.Е.Дижур
Межподзонные 2D поляроны и туннельная плотность состояний двумерной электронной системы высокой плотности в GaAs
-
- 4.39 **К.Э.Нагаев**, О.С.Айвазян, Т.В.Костюченко
Эффекты электрон-электронного рассеяния в широких баллистических микроконтактах
-

Метаматериалы и фотонные кристаллы

- 12.4 **Е.В.Наумова**, В.Я.Принц, С.В.Голод, В.А.Селезнев, В.А.Сейфи, В.В.Кубарев
Киральные метаматериалы на основе прецизионных метал-полупроводниковых спиралей

Вторник, 29 сентября

Секция 1	Секция 2
Гетероструктуры и сверхрешетки	Объемные полупроводники
<i>09:00-10:50, Большой зал Дом Ученых, Новосибирск (Н1)</i>	<i>09:00-10:50, Малый зал Дом Ученых, Новосибирск (Н2)</i>
<p>Приглашенные доклады</p> <p>3.1 А.А.Горбацевич Резонансы и локализованные состояния в сложных наноструктурах</p> <p>3.2 В.Д.Кулаковский, А.А.Деменев, С.С.Гаврилов, Н.А.Гиппиус, С.Г.Тиходеев Гистерезисные эффекты в кинетике накачиваемой и рассеянных поляритонных мод в планарных GaAs микрорезонаторах</p> <p>3.3 Н.А.Гиппиус, С.С.Гаврилов, Н.С.Маслова, В.Д.Кулаковский, С.Г.Тиходеев Поляризационные особенности рассеяния квази-двумерных экситонных поляритонов в полупроводниковых микрорезонаторах</p> <p>3.4 Л.Е.Воробьев, Д.А.Фирсов, В.А.Шалыгин, В.Ю.Паневин, А.Н.Софронов, М.Я.Винниченко, П.Тхумронгсилапа, С.Н.Данилов, А.Е.Жуков, А.И.Якимов, А.В.Двуреченский Поглощение и модуляция излучения в наноструктурах с квантовыми ямами и квантовыми точками р-типа</p>	<p>Приглашенный доклад</p> <p>1.1 В.Ф.Сапега, Н.С.Аверкиев, К.Плуг Поляризация дырок и ферромагнитный порядок в разбавленном магнитном полупроводнике (Ga,Mn)As</p> <p>1.2 А.И.Вейнгер, А.Г.Забродский, Т.В.Тиснек, С.И.Голощанов Спин-пайерлсовский переход в примесной системе легированного полупроводника вблизи фазового перехода изолятор - металл</p> <p>1.3 А.А.Фортунов, Ю.А.Нефедов, И.В.Кукушкин Электронный спиновый резонанс в режиме целочисленного и дробного квантового эффекта Холла</p> <p>1.4 А.А.Добровольский, А.И.Артакин, А.А.Винокуров, В.П.Зломанов, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов, О.М.Иваненко, К.В.Мицен Корреляционные эффекты в PbTe, легированном ванадием</p> <p>1.5 Н.Н.Агеева, И.Л.Бронева, А.Н.Кривонос, Т.А.Налет Участие электрон-фононного взаимодействия и субтерагерцовые автоколебания в сверхбыстрой автомодуляции поглощения света в GaAs</p>
10:50 – 11:05 Перерыв	

Одномерные и нульмерные системы	Поверхность, пленки, слои 2
11:05-13:05, Большой зал Дом Ученых, Новосибирск (Н1)	11:05-12:55, Малый зал Дом Ученых, Новосибирск (Н2)
<p>Приглашенные доклады</p> <p>5.1 Л.И.Магарилл, М.М.Махмудиан, М.В.Энтин Физические явления в низкоразмерных системах с локальными высокочастотными полями</p> <p>5.2 С.Н.Артеменко Генерация колебаний при протекании тока через примесь в одномерных проводниках</p> <p>5.3 О.В.Кибис, Г.Я.Слепян, С.А.Максименко, А.Hoffmann Эффект Раби в асимметричных наноструктурах</p> <p>5.4 Ю.А.Кумзеров Макроскопические системы нанопроволок из полупроводников</p>	<p>2.6 А.С.Терехов Заряженные цезий-индуцированные состояния на Ga - стабилизированной поверхности GaAs (001) [4x2] формируются цезиевыми кластерами</p> <p>2.7 Ю.Н.Дроздов, З.Ф.Красильник, А.В.Новиков, М.В.Шалеев, Д.В.Юрасов Влияние напряженных SiGe слоев на критическую толщину двумерного роста Ge</p> <p>2.8 А.В.Копылов, А.В.Принц, В.Я.Принц 3D упругие свободностоящие наноболочки: моделирование, получение, свойства</p> <p>2.9 А.А.Добровольский, В.И.Черничкин, З.М.Дашевский, В.А.Касиян, Л.И.Рябова, Д.Р.Хохлов Транспортные свойства и фотопроводимость нанокристаллических пленок PbTe(In)</p> <p>Приглашенный доклад</p> <p>2.10 В.А.Быков Приборостроение для нанотехнологии - состояние и перспективы развития</p>
13:05-14:30 Обед	

Секция 1	Секция 2
Спиновые явления, спинтроника, наноматематизм 2	Метаматериалы и фотонные кристаллы
14:30-15:50, Большой зал Дом Ученых, Новосибирск (Н1)	14:30-15:50, Малый зал Дом Ученых, Новосибирск (Н2)
<p>7.6 М.В.Федин, С.Л.Вебер, К.Ю.Марюнина, В.И.Овчаренко, Е.Г.Багрянская Изучение термически- и свето-индуцированных спиновых переходов в молекулярных магнетиках $Cu(hfac)_2L^R$ методом ЭПР</p> <hr/> <p>7.7 А.В.Кудинов Эффекты спиновой анизотропии в люминесценции экситонов и трионов из квантовых точек</p> <hr/> <p>7.8 Б.А.Аронзон, В.В.Рыльков, М.А.Панков, А.Б.Давыдов, А.С.Лагутин Анализ механизмов ферромагнитного упорядочения и электронный транспорт в 2D структурах GaAs/InGaAs/GaAs с δ-слоем Mn</p> <hr/> <p>7.9 А.В.Ларионов, А.В.Секретенко, Л.Е.Голуб Анизотропия спиновой релаксации электронов в двойных GaAs/AlGaAs туннельно-связанных квантовых ямах</p>	<p>Приглашенные доклады</p> <p>12.1 Н.С.Аверкиев, М.М.Глазов, А.Н.Поддубный Коллективные эффекты в фотолюминесценции квантовых точек в микрорезонаторах</p> <hr/> <p>12.2 Т. Hatano, Т. Ishihara, Н.А.Гиппиус, С.Г.Тиходеев Поперечный эффект фотонного увлечения циркулярно-поляризованным светом в наноперфорированном слое металла</p> <hr/> <p>12.3 А.Н.Поддубный, М.М.Воронов, Е.Л.Ивченко Экситонные поляритоны в фотонных квазикристаллах и аперидических структурах</p>
15:50 – 16:05 Перерыв	

Стендовая сессия 2

16:05-18:05, Второй этаже в холле перед Большим залом Дома Ученых СО РАН, Новосибирск

Одномерные и нульмерные системы

- 5.16 **Ю.В.Настаушев**, О.В.Наумова, Т.А.Гаврилова, Ф.Н.Дульцев, Л.В.Соколов, А.Л.Асеев
Исследование кремниевых нанокристаллов (вискеров) пассивированных высококонстантными диэлектриками на основе соединений титана
- 5.17 **Е.М.Дижур**, С.В.Зайцев-Зотов, М.А.Ильина
Низкотемпературная проводимость NbS₃ под давлением
- 5.18 **Н.Е.Капуткина**, Ю.Е.Лозовик
Спектры, локализация электронов и спиновая перестройка основного состояния горизонтальных и вертикальных молекул из квантовых точек
- 5.19 **И.А.Кокурин**, В.А.Маргулис
Спектр и баллистический транспорт электронов в полупроводниковой нанотрубке
- 5.20 Х.Дау, В.С.Днепровский, Е.А.Жуков, **М.В.Козлова**, Т.Умайер
Резонансное взаимодействие ультракоротких мощных импульсов лазера с экситонами в полупроводниковых квантовых точках
- 5.21 **K.Král** and M.Menšík
Optical line width in quantum dots
- 5.22 **К.А.Дроздов**, А.А.Добровольский, И.С.Васильевский, С.Г.Дорофеев, П.Н.Тананаев, Д.Р.Хохлов
Энергетический спектр и оптические свойства квантовых точек CdSe(Cu)
- 5.23 **А.Б.Талочкин**, И.Б.Чистохин, В.А.Марков
ИК фотопроводимость многослойных Ge/Si структур с квантовыми точками Ge
- 5.24 **А.В.Родина**, Ал.Л.Эфрос
Тонкая структура биэкситонов в сферических нанокристаллах полупроводников квазикубической симметрии
- 5.25 **Т.С.Шамирзаев**, К.С.Журавлев, F.Trojánek, B.Dzurňák, P.Malý
Захват носителей заряда в квантовые точки InAs/AlAs
- 5.26 Я.И.Родионов, **И.С.Бурмистров**, А.С.Иоселевич
Сопrotивление зарядовой релаксации в задаче о кулоновской блокаде
- 5.27 А.И.Якимов, **А.А.Блошкин**, А.В.Двуреченский
Экситоны в двойных квантовых точках Ge/Si II-го типа

- 5.28 **Н.Е.Капуткина**, Ю.Е.Лозовик, Р.Ф.Мунтяну, Ю.Х.Векилов
Апериодические одномерные последовательности квантовых точек во внешних электрическом и магнитном поле
- 5.29 **А.Б.Талочкин**, В.А.Марков, А.Г.Черков
Релаксация механических напряжений в многослойных Ge/Si структурах с квантовыми точками Ge
- 5.30 **М.А.Семина**, Р.А.Сергеев, Р.А.Сулис
Влияние локализации в неоднородных квантовых проволоках на энергии связи экситонов и трионов
- 5.31 **К.С.Журавлев**, И.Г.Александров, Р.О.Holtz
Линейно поляризованная микрофотолюминесценция квантовых точек GaN, сформированных в матрице AlN
- 5.32 **В.А.Петров**, А.В.Никитин
Управление электрическим полем электронными интерференционными эффектами в полупроводниковых 1D наноструктурах
- 5.33 Н.В.Сибирёв, В.Г.Дубровский, Г.Э.Цырлин, Ю.Б.Самсоненко, М.А.Тимофеева, А.Г.Гладышев, М.В.Назаренко
Нелинейные эффекты при росте полупроводниковых нитевидных нанокристаллов
- 5.34 **А.Н.Резницкий**, А.А.Клочихин, С.А.Пермогоров, В.В.Коренев, И.В.Седова, С.В.Сорокин, С.В.Иванов
Люминесценция двойных квантовых ям CdSe/ZnSe с самоорганизованными квантовыми точками
- 5.35 **К.Г.Беляев**, В.Х.Кайбышев, А.А.Торопов, Т.В.Шубина, В.Н.Жмерик, С.В.Иванов, П.С.Копьев
Эффекты экситон-плазмонного взаимодействия в InGaN с наночастицами золота, осажденными из коллоидного раствора
- 5.36 **А.В.Ненашев**, А.Ф.Зиновьева, А.В.Двуреченский
Вариационный метод вычисления энергетических уровней в квантовых точках пирамидальной формы
- 5.37 О.М.Сресели, **О.С.Ельцина**, Л.В.Беляков, Д.Н.Горячев
Рост фототока в нанопористом кремнии при больших энергиях квантов
- 5.38 А.В.Антонов, М.Н.Дроздов, Ю.Н.Дроздов, **Л.Д.Молдавская**, В.И.Шашкин, О.И.Хрыкин, А.Н.Яблонский
Фотопроводимость в области 1 - 2.5 мкм при комнатной температуре в структурах InAs/GaAs с нанокластерами InAs, выращенных методом МОГФЭ
- 5.39 **А.Н.Яблонский**, А.В.Новиков, Д.Н.Лобанов, З.Ф.Красильник
Механизмы излучательной рекомбинации в структурах SiGe/Si с самоформирующимися Ge(Si) островками
- 5.40 **А.М.Гишинский**, С.П.Мощенко, А.А.Лямкина, Д.В.Дмитриев, К.С.Журавлев
Фотолюминесценция квантовых точек InAs/GaAs, полученных методом капельной эпитаксии

Широкозонные материалы

- 6.7 **Н.Г.Колин**, А.Я.Поляков, Н.Б.Смирнов, А.В.Говорков, А.В.Корулин, Д.И.Меркурисов, В.М.Бойко, В.М.Залётин
О возможности регистрирования нейтронов полупроводниковыми детекторами на основе нитрида галлия

- 6.8 В.А.Шалыгин, Л.Е.Воробьев, Д.А.Фирсов, В.Ю.Паневин, А.Н.Софронов, **Г.А.Мелентьев**, А.В.Андрианов, А.О.Захарьин, Н.Н.Зиновьев, S.Suihkonen, H.Lipsanen
Терагерцовая люминесценция n-GaN в электрическом поле
- 6.9 И.Г.Аксянов, **В.Н.Бессолов**, Ю.В.Жилияев, М.Е.Компан, Е.В.Коненкова, С.А.Кукушкин, А.В.Осипов, В.П.Рубец, Н.А.Феоктистов, Ш.Шарофидинов, М.П.Щеглов
Широкозонные III-нитридные слои на Si : роль промежуточных α -SiC+ β -SiC комбинированных слоев
- 6.10 **Ю.Т.Ребане**, Р.И.Горбунов, Ф.Е.Латышев, Ю.С.Лелико, А.С.Зубрилов, А.И.Цюк, Ю.Г.Шретер
Цилиндрические ростовые структуры в пленках нитрида галлия
- 6.11 **М.Д.Павлюк**, Ю.М.Иванов, В.М.Каневский, Е.А.Борисова, В.Ф.Дворянкин и А.А.Кудряшов
Выращивание монокристаллов CdTe и CdZnTe для получения детекторов цифрового рентгеновского изображения
- 6.12 В.В.Емцев, А.М.Иванов, **В.В.Козловский**, А.А.Лебедев, Г.А.Оганесян, Д.С.Полоскин, Н.Б.Строкан
Радиационное дефектообразование в карбиде кремния при электронном и протонном облучении
- 6.13 **Н.Г.Колин**, А.Я.Поляков, Н.Б.Смирнов, А.В.Говорков, А.В.Марков, Т.Г.Югова, А.В.Корулин, Д.И.Меркурисов, В.М.Бойко, Е.Б.Якимов
Особенности радиационного дефектообразования в эпитаксиальных плёнках нитрида галлия, полученных методом латерального зарощивания

Высокочастотные явления в полупроводниках

- 9.3 **М.Л.Орлов**
Механизмы детектирования субмиллиметрового излучения короткоканальными полевыми транзисторами
- 9.4 Н.С.Аверкиев, С.О.Слипченко, **З.Н.Соколова**, И.С.Тарасов
AlGaAs-GaAs волновод для среднего и дальнего ИК излучения
- 9.5 **В.Н.Трухин**, Н.Н.Зиновьев
Радиационное экранирование терагерцового поля, генерируемого ультракороткими световыми импульсами в фотопроводнике
- 9.6 В.Я.Алешкин, **А.А.Дубинов**
Генерация разностной частоты терагерцового диапазона в двухчастотном InGaAs/InGaAsP/InP лазере
- 9.7 **М.А.Ормонт**
Особенности поведения бесфононной прыжковой проводимости в области кроссовера от линейной к квадратичной частотной зависимости

Среда, 30 сентября

Секция 1	Секция 2
Двумерные системы 2	Полупроводниковые приборы и устройства
<i>09:00-11:00, Большой зал Дом Ученых, Новосибирск (Н1)</i>	<i>09:00-11:00, Малый зал Дом Ученых, Новосибирск (Н2)</i>
<p>Приглашенные доклады</p> <p>4.4 А.В.Горбунов, Д.А.Демин, В.Б.Тимофеев Фазовая диаграмма Бозе-конденсации диполярных экситонов в латеральной ловушке в GaAs/AlGaAs гетероструктурах</p> <p>4.5 З.Д.Квон, Е.Б.Ольшанецкий, Д.А.Козлов, Н.Н.Михайлов, С.А.Дворецкий, И.О.Парм Двумерный полуметалл и экситонный диэлектрик в квантовых ямах на основе HgTe</p> <p>4.6 С.И.Дорожкин Знакопеременные магнетоосцилляции фототока и фото-ЭДС в двумерных электронных системах под СВЧ облучением</p> <p>4.7 А.В.Чаплик, А.В.Каламейцев Максвелловская релаксация непрямых экситонов в двойных квантовых ямах</p> <p>4.8 Р.В.Кузьмин, В.В.Криволапчук, Е.С.Москаленко, М.М.Мездрогина, Э.Ю.Даниловский Осцилляции во времени интенсивности линии излучения экситонного конденсата в двойных квантовых ямах GaAs/AlGaAs</p>	<p>Приглашенные доклады</p> <p>13.1 Л.Я.Карачинский, С.А.Блохин, Д.А.Лотт, М.В.Максимов, А.Мутиг, А.М.Надточий, И.И.Новиков, В.А.Щукин, Д.Бимберг, Н.Н.Леденцов Вертикально-излучающие лазеры спектрального диапазона 850нм со скоростью передачи данных 39Гбит/с</p> <p>13.2 С.В.Иванов, И.В.Седова, С.В.Сорокин, С.В.Гронин, Н.А.Гамов, Е.В.Жданова, В.Б.Студенов, Д.В.Перегудов, М.М.Зверев, И.М.Олихов, П.С.Копьев Лазерные сборки с электронно-лучевой накачкой на основе квантоворазмерных структур ZnCdSe/ZnMgSSe</p> <p>13.3 В.И.Иванов-Омский, Н.Л.Баженов, К.Д.Мынбаев, В.А.Смирнов, Н.Н.Михайлов, Г.Ю.Сидоров, В.С.Варавин Излучательные гетероструктуры HgCdTe среднего инфракрасного диапазона, выращенные молекулярно-лучевой эпитаксией</p> <p>13.4 А.И.Якимов, В.В.Кириенко, А.В.Двуреченский, А.И.Никифоров, А.А.Блошкин, В.А.Донченко, А.А.Землянов, Г.М.Цепелев Быстрые фотодетекторы на гетероструктурах Ge/Si с квантовыми точками</p> <p>13.5 В.А.Гриценко Новое поколение флэш памяти на основе high-k диэлектриков</p>
11:00 – 11:15 Перерыв	

Одномерные и нульмерные системы 2	Примеси и дефекты 2
11:15-13:05, Большой зал Дом Ученых, Новосибирск (Н1)	11:15-13:15, Малый зал Дом Ученых, Новосибирск (Н2)
<p>Приглашенный доклад</p> <p>5.5 В.А.Сабликов, Б.С.Щамхалова, А.А.Суханов Механизмы образования спин-поляризованного состояния и спинового тока в квантовых контактах</p> <p>5.6 А.Г.Погосов, М.В.Буданцев, А.А.Шевырин, А.Е.Плотников, А.К.Бакаров, А.И.Торопов, Д.А.Насимов Пробой кулоновской блокады в подвешенном одноэлектронном транзисторе, обусловленный возбуждением собственных мод его механических колебаний</p> <p>5.7 Е.Е.Вдовин, Ю.Н.Ханин, О.Макаровский, А.Патанэ, Л.Ивс Детектирование фотонов при резонансном туннелировании через единичную квантовую точку</p> <p>5.8 А.А.Торопов, Т.В.Шубина, К.Г.Беляев, С.В.Иванов, П.С.Копьев, Y.-Ogawa, F.-Minami, J.P.Bergman, B.-Monemar Плазмонное усиление переходов локализованных экситонов в полупроводниковых структурах</p> <p>5.9 Н.П.Степина, Е.С.Коптев, А.В.Двуреченский, А.И.Никифоров Проводимость двумерного массива квантовых точек в режиме сильной и слабой локализации</p>	<p>8.4 В.Н.Шумский Локализованные состояния, захват электронов и фоточувствительность в PbSnTe:In</p> <p>8.5 М.М.Мездрогина, В.В.Криволапчук, Э.Ю.Даниловский, Р.В.Кузьмин, Ю.В.Кожанова Сенсибилизация излучения и механизмы миграции электронных возбуждений в кристаллах III- нитридов и наноструктурах на их основе, легированных Eu, Sm, Er, Tm</p> <p>8.6 А.Г.Казанский, Guanglin Kong, Xiangbo Zeng Спектральные зависимости поглощения в двухфазных пленках гидрированного кремния</p> <p>8.7 В.Я.Алешкин, А.А.Антонов, В.И.Гавриленко, Б.Н.Звонков, Д.В.Козлов Примесная фотопроводимость в напряженных гетероструктурах p-InGaAs/GaAsP</p> <p>8.8 А.Э.Климов, В.Н.Шумский Инжекция из контактов и анизотропия гальваномагнитных явлений в пленках узкозонного сегнетоэлектрика PbSnTe:In</p> <p>8.9 Л.С.Смирнов Размышления о реакциях в решетках кристаллов</p>
13:15-14:30 Обед	

Секция 1	Секция 2
Широкозонные материалы	Полупроводниковые приборы и устройства 2
14:30-16:00, Большой зал Дом Ученых, Новосибирск (Н1)	14:30-16:00, Малый зал Дом Ученых, Новосибирск (Н2)
<p>Приглашенные доклады</p> <p>6.1 Т.В.Шубина, М.М.Глазов, А.А.Торопов, Н.А.Гиппиус, Г.Позина, В.Монетар, П.С.Копьев "Медленный свет" в полупроводниковых кристаллах и наноструктурах</p> <p>6.2 Р.А.Хмельницкий, А.А.Гиппиус Алмаз-графитовые гетероструктуры в ионно-имплантированном алмазе</p> <p>6.3 В.М.Залетин Широкозонные полупроводниковые соединения для детекторов рентгеновского и гамма-излучения</p>	<p>Приглашенный доклад</p> <p>13.6 О.В.Наумова, Б.И.Фомин, Л.Н.Сафронов, Д.А.Насимов, М.А.Ильницкий, В.П.Попов, А.В.Латышев, А.Л.Асеев Изготовление и свойства КНИ-нанопроволочных транзисторов как сенсоров заряда</p> <p>13.7 М.А.Демьяненко, Д.Г.Есаев, В.Н.Овсяк, Б.И.Фомин Матричные микроболометрические приемники терагерцового диапазона</p> <p>13.8 Ю.Б.Васильев, А.А.Усикова, Н.Д.Ильинская, П.В.Петров, Ю.Л.Иванов Спиральный фотоприемник на основе InSb</p> <p>13.9 И.А.Деребезов, В.А.Гайслер, А.К.Бакаров, А.И.Торопов, М.М.Качанова, В.М.Энтин, И.И.Рябцев Одномодовый лазер с вертикальным резонатором для миниатюрного атомного стандарта частоты</p>
16:00 – 16:15 Перерыв	

Стендовая сессия 3

16:15-18:15, Второй этаже в холле перед Большим залом Дома Ученых СО РАН, Новосибирск

Примеси и дефекты

- 8.23 Е.П.Скипетров, **Н.А.Пичугин**, Б.Б.Ковалев, Е.И.Слынько, В.Е.Слынько
Электронная структура разбавленных магнитных полупроводников $Pb_{1-x-y}Sn_xCr_yTe$
- 8.24 Н.С.Аверкиев, М.Е.Левинштейн, П.В.Петров, А.Е.Черняков, **Е.И.Шабунина**, Н.М.Шмидт, Е.Б.Якимов
Особенности безизлучательной рекомбинации в синих светодиодах на основе квантово-размерных структур InGaN/GaN
- 8.25 **В.В.Привезенцев**
Фотолюминесценции кристаллов кремния n-типа, легированных цинком
- 8.26 В.А.Морозова, О.Г.Кошелев, Е.П.Веретенкин, В.Н.Гаврин, **Ю.П.Козлова**
Примесный фотовольтаический эффект на p-i-n структурах из нелегированного GaAs
- 8.27 Б.А.Андреев, З.Ф.Красильник, **Д.И.Крыжков**, К.Е.Кудрявцев, В.П.Кузнецов
Особенности кинетики ЭЛ иона Er в структурах Si:Er с активным слоем, позиционированным в ОПЗ
- 8.28 **Н.А.Давлеткильдеев**, М.М.Нукенов, Н.В.Сологуб
Фазовый состав микродефектов в сильно легированном n-GaAs
- 8.29 Л.Н.Мазалов, Ю.П.Диков, Н.А.Крючкова, В.В.Соколов, Е.В.Коротаев, А.Д.Федоренко
Электронное строение катион-замещенных полупроводников $CuCr_{1-x}M_xS_2$ (M -V,Fe; x = 0 - 0.4) по данным рентгеноэлектронной и рентгеновской спектроскопии
- 8.30 **К.Е.Кудрявцев**, В.Б.Шмагин, Д.В.Шенгуров, З.Ф.Красильник
Оптически активный центр Er-1 в диодных СМЛЭ структурах Si:Er/Si
- 8.31 **П.В.Петров**, Ю.Л.Иванов, Н.С.Аверкиев
Поляризационная спектроскопия экситонов связанных на акцепторах в квантовых ямах GaAs/AlGaAs. Особенности фоновых повторений
- 8.32 **Г.И.Воронкова**, А.В.Батунина, В.В.Воронков, В.Н.Головина, А.С.Гуляева, Н.Б.Тюрина, **М.Г.Мильвидский**
Природа глубоких центров, возникающих в кремнии, легированном азотом, после термообработок 200 - 900°C
- 8.33 **С.А.Блохин**, В.М.Лантратов, М.З.Шварц, А.Р.Ковш, М.В.Максимов, А.М.Надточий, С.А.Минтаиров, Н.А.Калюжный, Н.Н.Леденцов
In(Ga)As квантовые точки как активная среда для фотоэлектрических преобразователей в системе материалов $A^{III}B^V$

- 8.34 **А.Т.Лончаков**
Спин-решеточная релаксация и параупругая восприимчивость в ультразвуковых свойствах кубических кристаллов $A^2B^6:3d$
- 8.35 **Т.Т.Корчагина**, В.А.Володин, А.А.Попов, J.Koch, B.Chichkov
Кристаллизация кластеров кремния в пленках SiN_x ($x < 4/3$) с применением фемто- и наносекундных лазерных обработок
- 8.36 А.Н.Акимов, А.Э.Климов, Н.С.Пашин, **В.Н.Шерстякова**, В.Н.Шумский
Переходные процессы в $PbSnTe:In$ при инжекции носителей заряда из контактов
- 8.37 **В.В.Цыпленков**, В.Н.Шагин
Релаксация состояний мелких доноров в деформированном кремнии при взаимодействии с междолинными фононами
- 8.38 И.А.Курова, **Н.Н.Ормонт**
Особенности фотопроводимости нелегированных слоистых пленок аморфного гидрированного кремния
- 8.39 **И.Е.Тыщенко**, В.П.Попов
Накопление заряда в структурах кремний-на-изоляторе с азотированным слоем SiO_2
- 8.40 В.В.Болотов, **В.Е.Кан**
Фотолюминесценция в термообработанном кремнии
- 8.41 **Э.Ю.Даниловский**, М.М.Мездрогина, В.В.Криволапчук, Р.В.Кузьмин, М.В.Еременко, Г.А.Бордовский, А.В.Марченко, М.В.Чукичев
Формирование спектров излучения в кристаллах ZnO , легированных Fe , Cu
- 8.42 **М.Ю.Леонов**, А.В.Войцеховский, С.А.Шульга, Н.Х.Талипов
Расчет профилей распределения радиационных дефектов в КРТ при воздействии высокоинтенсивными импульсными лазерными пучками
- 8.43 **К.Е.Кудрявцев**, В.Б.Шмагин, В.П.Кузнецов, Д.В.Шенгуров, З.Ф.Красильник
Особенности температурного гашения электролюминесценции СМЛЭ $Si:Er/Si$ диодов с различными типами эрбиевых излучающих центров
- 8.44 **К.В.Феклистов**, Л.И.Федина, А.Г.Черков
Неоднородная преципитация бора в кремнии на стадии Оствальдовского созревания

Органические полупроводники, молекулярные системы

- 10.3 **В.Ш.Алиев**, И.А.Бадмаева
Синтез пленок Pb фталоцианина и исследование их структуры и электрофизических свойств

- 10.4 **Е.В.Тихонов**, И.А.Белогорохов, Д.Р.Хохлов, Л.Г.Томилова
Спектры комбинационного рассеяния света полупроводниковых структур на основе фталоцианина эрбия
- 10.5 **А.Р.Тамеев**, Р.Г.Рахмеев, А.Н.Лачинов, Р.Б.Салихов, А.А.Бунаков, В.Р.Никитенко, А.В.Ванников
Транспорт носителей заряда в пленках полидифениленфталида
- 10.6 **А.А.Лачинов**, Н.В.Воробьева, В.М.Корнилов
Управляющее напряжение для инжекционного гигантского магнетосопротивления в системе металл\полимер
- 10.7 **А.В.Зиминов**, В.В.Криволапчук, М.М.Мездрогина, С.М.Рамш, И.Г.Спиридонов, Т.А.Юрре
Формирование спектров излучения фталоцианинов европия
- 10.8 **В.В.Шелковников**, Т.В.Романова, Н.А.Орлова, С.В.Рыхлицкий, Е.В.Спесивцев
Оптические свойства тонких твердых пленок полиметиновых красителей в видимой и ближней ИК-области
- 10.9 **И.А.Бадмаева**, Л.Л.Свешникова
Исследование топохимической фотополимеризации тонких пленок Ленгмюра-Блоджетт ацетиленовых кислот
- 10.10 **Н.А.Крючкова**, Л.Н.Мазалов, А.И.Боронин, Р.В.Гуляев, Т.В.Басова, В.А.Пляшкевич
Исследование электронного строения комплексов CuPc и CuPcFM_{16} методами рентгеноэлектронной спектроскопии и квантовой химии
- 10.11 **И.Р.Набиуллин**, А.Н.Лачинов
К вопросу о возникновении электронного переключения в системе металл-полимер-металл в результате изменения граничных условий
- 10.12 **Р.Б.Салихов**, А.Н.Лачинов, Р.Г.Рахмеев, А.А.Бунаков
Барьеры в гетероструктурах кремний-полимер-металл
- 10.13 **Р.В.Гайнутдинов**, Л.В.Саргош, Н.Д.Степина, К.Л.Сорокина, А.Л.Толстихина
Влияние условий синтеза на структуру и электрические свойства нанокompозитов допированный полианилин/диэлектрическая матрица
- 10.14 А.Н.Лачинов, **Р.Г.Рахмеев**, Р.М.Гадиев, Р.Б.Салихов
Исследование полевого эффекта на интерфейсе полимер/полимер

Четверг, 1 октября

Секция 1	Секция 2
Двумерные системы 3	Примеси и дефекты 3
16:00-18:30, Конференц-зал Конгресс-центра "Рубин", Томск (Т1)	16:00-18:20, Конференц-зал ИОА СО РАН, Томск (Т2)
<p>Приглашенный доклад</p> <p>4.9 Ю.И.Латышев, А.П.Орлов, А.Ю.Латышев, Д.Виньоль Межслоевая туннельная спектроскопия NbSe₃, KMo₆O₁₇ и графита в импульсных магнитных полях до 55 Тл</p> <p>4.10 А.В.Щербаков, А.В.Акимов, Д.Р.Яковлев, Т.Berstermann, M.Bayer Сверхбыстрая оптическая спектроскопия с импульсами деформации в полупроводниковых наноструктурах</p> <p>4.11 В.С.Багаев, В.В.Зайцев, В.С.Кривобок, Д.Н.Лобанов, С.Н.Николаев, А.В.Новиков, Е.Е.Онищенко Условия образования и свойства конденсированной фазы в узких квантовых ямах SiGe/Si</p> <p>4.12 В.В.Соловьев, И.В.Кукушкин, Ш.Шмульт Гигантские осцилляции межподзонного расщепления и перенос заряда в двуслойной электронной системе в квантовых магнитных полях.</p> <p>4.13 Э.В.Девятков, А.Лорке, Б.Маркварт, Г.Биасол, Л.Сорба Экспериментальная реализация интерферометра типа Фабри-Перо при помощи краевых состояний в режиме квантового эффекта Холла</p> <p>4.14 А.Б.Ваньков, Л.В.Кулик, С.Дикман, И.В.Кукушкин, В.Е.Кирпичев Циклотронная спин-флип мода в квантово-холловских ферромагнетиках</p> <p>4.15 Л.И.Магарилл, М.В.Энтин Кинетические явления в многосортном электронном газе</p>	<p>8.10 Н.Х.Талипов, А.В.Войцеховский Электрофизические свойства ионно-имплантированных кристаллов и гетероэпитаксиальных слоев МЛЭ КРТ</p> <p>8.11 В.Н.Брудный, А.В.Кособуцкий Свойства дефектных состояний GaN и AlN под давлением</p> <p>8.12 В.И.Окулов, Г.А.Альшанский, Т.Е.Говоркова, А.Т.Лончаков, К.А.Окулова, С.М.Подгорных, С.Ю.Паранчич К экспериментальному обоснованию гибридизации электронных состояний на примесях переходных элементов в полупроводнике</p> <p>8.13 Л.В.Красильникова, А.Н.Яблонский, Б.А. Андреев, З.Ф.Красильник, В.П.Кузнецов, В.Г.Шенгуров Кинетика эрбиевой люминесценции в структурах Si:Er/Si и Si_{1-x}Ge_x:Er/Si при межзонном и прямом оптическом возбуждении</p> <p>8.14 Т.А.Комиссарова, М.А.Шахов, В.Н.Жмерик, Т.В.Шубина, Р.В.Парфеньев, С.В.Иванов Аномальная зависимость коэффициента Холла от магнитного поля в пленках InN</p> <p>8.15 Б.Г.Захаров, В.И.Стрелов, Ю.А.Осипьян Проблемы и перспективы выращивания монокристаллов в условиях микрогравитации</p> <p>8.16 А.Т.Лончаков, В.И.Окулов, С.Ю.Паранчич Низкотемпературные аномалии электронной и фононной теплопроводности селенида ртути с примесями 3d переходных металлов</p>

Пятница, 2 октября

Секция 1	Секция 2
Углеродные наноматериалы	Полупроводниковые приборы и устройства 3
09:00-11:00, Конференц-зал Конгресс-центра "Рубин", Томск (Т1)	09:00-11:00, Конференц-зал ИОА СО РАН, Томск (Т2)
<p>Приглашенные доклады</p> <p>11.1 Ю.Е.Лозовик Коллективные свойства и фазы графеновых структур</p> <p>11.2 В.А.Волков Особенности электронных состояний в графене</p> <p>11.3 В.Я.Принц Графен и гибридные структуры на его основе</p> <p>11.4 И.В.Загороднев, В.А.Волков Граничные условия для уравнения Вейля-Дирака и краевые состояния таммовского типа в графене</p> <p>11.5 В.Я.Алешкин, А.А.Дубинов, В.И.Рыжий Лазер на графене</p>	<p>13.10 Г.С.Соколовский, В.В.Дюделев, Д.А.Винокуров, А.Г.Дерягин, А.Е.Жуков, С.Н.Лосев, А.В.Лютеецкий, М.В.Максимов, И.И.Новиков, Н.А.Пихтин, С.О.Слипченко, З.Н.Соколова, Э.У.Рафаилов, В.Сиббет, В.М.Устинов, В.И.Кучинский, И.С.Тарасов Аномальные динамические характеристики полупроводниковых лазеров с квантоворазмерной активной областью</p> <p>13.11 Л.Н.Сафронов, М.А.Ильницкий, О.В.Наумова, В.П.Попов Характеристики асимметричного двухзатворного МДП транзистора на КНИ</p> <p>13.12 В.Л.Курочкин Полупроводниковые детекторы одиночных фотонов в видимом и ближнем ИК диапазоне</p> <p>13.13 В.А.Ткаченко, О.А.Ткаченко, З.Д.Квон, А.И.Торопов, А.В.Латышев, А.Л.Асеев Мезоскопические наноустройства: структура и свойства</p> <p>13.14 М.В.Якушев, В.С.Варавин, С.А.Дворецкий, И.В.Сабина, Ю.Г.Сидоров, А.В.Сорочкин, А.О.Сусляков Гетероструктуры HgCdTe на подложках Si(310) для инфракрасных фотоприемников</p> <p>13.15 А.В.Антонов, В.И.Гавриленко, А.В.Иконников, К.В.Маремьянин, А.А.Ластовкин, С.В.Морозов, Д.В.Ушаков, Ю.Г.Садофьев, N.Samal Исследование квантовых каскадных лазеров ТГц диапазона и их применение для спектроскопии полупроводниковых структур</p>
11:00 – 11:15 Перерыв	

Гетероструктуры и сверхрешетки 2	Высокочастотные явления в полупроводниках
11:15-12:25, Конференц-зал Конгресс-центра "Рубин", Томск (Т1)	11:15-12:15, Конференц-зал ИОА СО РАН, Томск (Т2)
<p data-bbox="163 272 539 304">Приглашенный доклад</p> <p data-bbox="163 328 1137 488">3.5 В.И.Гавриленко, А.В.Антонов, С.В.Морозов, К.В.Маремьянин, А.Н.Яблонский, Д.И.Курицын, И.В.Ерофеева, С.М.Сергеев Исследование релаксации примесной фотопроводимости в терагерцовом диапазоне в гетероструктурах $In_{0.1}Ga_{0.9}As_{0.8}P_{0.2}$ и $Ge/Ge_{0.9}Si_{0.1}$ с квантовыми ямами</p> <p data-bbox="163 536 1025 695">3.6 Т.М.Бурбаев, М.Н.Гордеев, Д.Н.Лобанов, А.В.Новиков, Н.С.Пташкин, М.М.Рзаев, Н.Н.Сибельдин, В.А.Цветков, Д.В.Шепель Электронно-дырочная жидкость в SiGe-слоях гетероструктур Si/SiGe/Si</p> <p data-bbox="163 719 1115 847">3.7 Б.А.Андреев, Э.Ф.Красильник, Д.И.Крыжков, А.Н.Яблонский, В.П.Кузнецов, T.Gregorkiewicz, Ng.Ng. На Излучательные свойства эпитаксиальных структур Si:Er/SOI</p>	<p data-bbox="1182 272 1585 304">Приглашенные доклады</p> <p data-bbox="1182 328 2078 488">9.1 Д.Р.Хохлов, А.В.Галеева, Д.Е.Долженко, Л.И.Рябова, А.В.Никорич, С.Д.Ганичев, С.Н.Данилов, В.В.Бельков Фотоэлектрические эффекты в легированных полупроводниках на основе теллурида свинца при воздействии лазерного терагерцового излучения</p> <p data-bbox="1182 512 2134 608">9.2 Л.Е.Голуб, Е.Л.Ивченко, E.Deyo, V.Spivak Квазиклассическая теория фотогальванических эффектов в нецентросимметричных полупроводниках</p>
12:15-14:00 Обед	

Секция 1	Секция 2
Одномерные и нульмерные системы 3	Примеси и дефекты 4
14:00-16:00, Конференц-зал Конгресс-центра "Рубин", Томск (Т1)	14:00-16:00, Конференц-зал ИОА СО РАН, Томск (Т2)
<p>5.10 М.Г.Прокудина, В.С.Храпай Нелокальное взаимодействие между квантовыми контактами управляемое магнитным полем</p>	<p>8.17 В.Р.Галахов, Э.З.Курмаев, Т.П.Суркова 3d примеси в полумагнитных полупроводниках на основе соединений ZnO и Cu₂O</p>
<p>5.11 А.В.Савельев, А.Е.Жуков Микролазер с одиночной квантовой точкой</p>	<p>8.18 К.А.Ковалевский, Р.Х.Жукавин, С.Г.Павлов, Х.В.Хьюберс, В.Н.Шастин Стимулированное излучение доноров V-группы в однооснодеформированном кремнии</p>
<p>5.12 С.В.Зайцев-Зотов, В.Ф.Насретдинова, В.Е.Минакова, С.Г.Зыбцев Поиск вклада солитонов в проводимость и оптические свойства квазиодномерных проводников</p>	<p>8.19 А.Н.Яблонский, Л.В.Красильникова, Б.А.Андреев, Д.И.Крыжков, В.П.Кузнецов, В.Г.Шенгуров, З.Ф.Красильник Особенности спектров возбуждения эрбиевой ФЛ в эпитаксиальных структурах Si:Er/Si, SiGe:Er/Si и Si:Er/SOI</p>
<p>5.13 В.Г.Талалаев, А.В.Сеничев, Б.В.Новиков, Н.Д.Захаров, Р.Werner, J.W.Tomm, Ю.Б.Самсоненко, А.Д.Буравлев, И.П.Сошников, Г.Э.Цырлин Инверсия и резонанс состояний в туннельно-инжекционных наноструктурах InGaAs</p>	<p>8.20 Р.В.Парфеньев, Д.В.Шамшур, А.Г.Андрианов, А.В.Черняев, Н.Ю.Михайлин Влияние гидростатического сжатия на сверхпроводящие свойства Pb_{0.3}Sn_{0.7}Te, легированного индием</p>
<p>5.14 В.П.Кочерешко, А.В.Платонов Влияние движения экситона на его магнитные свойства</p>	<p>8.21 В.Я.Алешкин, А.В.Антонов, В.И.Гавриленко, Л.В.Гавриленко, Б.Н.Звонков Резонансы Фано в спектре фототока p-GaAs и гетероструктур с квантовыми ямами p-InGaAs/GaAsP</p>
<p>5.15 А.Г.Милёхин, Л.Л.Свешникова, Т.А.Дуда, Н.В.Суровцев, С.В.Адищев, Д.Р.Т.Цан Гигантское комбинационное рассеяние света квантовыми точками CdS</p>	<p>8.22 И.И.Ижнин, Р.Я.Мудрый, С.А.Дворецкий, Н.Н.Михайлов, Ю.Г.Сидоров, В.С.Варавин, К.Д.Мынбаев, М.Поцяск Исследование дефектной структуры МЛЭ гетероэпитаксиальных слоев CdHgTe, легированных As</p>
16:00 – 16:15 Перерыв	

Стендовая сессия 4

16:15-18:15, Второй этаж в холле перед конференц-залом Конгресс-центра "Рубин", Томск

Спиновые явления, спинтроника, наноманетизм

- 7.10 **Е.В.Кожемякина**, К.С.Журавлев, Л.Вина, А.Амо
Спиновое расщепление линии экситонов в объемных образцах GaAs и AlGaAs
- 7.11 **М.М.Глазов**, В.Д.Кулаковский
Тонкая структура энергетического спектра двух электронов в квантовой точке
- 7.12 **А.Ф.Зиновьева**, А.В.Ненашев, В.А.Зиновьев, А.В.Двуреченский
Электрическое поле, возникающее из-за структурной асимметрии в системе с квантовыми точками
- 7.13 О.В.Вихрова, Ю.А.Данилов, Б.Н.Звонков, **А.В.Кудрин**
Планарный эффект Холла в GaAs структурах с одиночным дельта-слоем марганца
- 7.14 **А.Ф.Зиновьева**, Н.П.Степина, А.В.Двуреченский, А.С.Дерябин, А.С.Любин, Г.Д.Ивлев, N.A.Sobolev, M.C.Carmo
Эффект лазерного отжига в спиновых свойствах электронов в структурах с Ge/Si квантовыми точками
- 7.15 **В.Г.Гришаев**, С.Н.Косолобов, Г.Э.Шайблер, А.С.Терехов
Эмиссия с поверхностных состояний ограничивает предельно-достижимую степень спиновой поляризации электронов, эмитированных из p^+ -GaAs(Cs,O)
- 7.16 **С.Г.Новокшинов**
Электропроводность и спиновая поляризация 2D электронного газа в поперечном магнитном поле при наличии спин-орбитальной связи
- 7.17 **Л.Ю.Щурова**, В.А.Кульбачинский
Термодинамические, транспортные и магнетотранспортные свойства свободных носителей заряда в легированных марганцем структурах с квантовой ямой GaAs/InGaAs/GaAs
- 7.18 **Т.С.Шамирзаев**, J.Debus, Д.Р.Яковлев, К.С.Журавлев, M.Bayer
Спиновая релаксация экситонов в непрямозонных квантовых точках InAs/AlAs первого рода
- 7.19 **В.В.Рыльков**, Б.А.Аронзон, С.Н.Николаев, В.В.Тугушев, Е.С.Демидов, А.С.Левчук, В.П.Лесников, В.В.Подольский
Аномальный эффект Холла в слоях Si, сильно легированных Mn
- 7.20 **С.Н.Гриняев**
Спиновая поляризация при туннелировании электронов в гетероструктурах GaAs/AlAs (001)
- 7.21 **С.С.Хлудков**
Перспективы использования арсенида галлия в качестве материала для спинтроники

Углеродные наноматериалы

- 11.6 **С.П.Лебедев**, В.Н.Петров, А.А.Лаврентьев, И.С.Котоусова, А.Н.Смирнов, А.А.Лебедев
Формирование пленок нанougлерода на поверхности монокристаллического карбида кремния методом сублимации в вакууме
- 11.7 **Р.М.Тазиев**, В.Я.Принц
3D гибридные оболочки графен- полупроводник
- 11.8 Б.Д.Шанина, **А.М.Данишевский**, А.И.Вейнгер, А.А.Ситникова, Р.Н.Кютт, А.В.Щукарев, С.К.Гордеев
О магнетизме палладиевых кластеров в нанопористом углероде
- 11.9 **Г.В.Тихомирова**, Я.Ю.Волкова, А.Н.Бабушкин
Электропроводность фуллерена C₆₀ и одностенных углеродных нанотрубок при давлениях до 50 ГПа
- 11.10 И.А.Корнеев, **В.А.Селезнев**, В.Я.Принц, А.Е.Зарвин, В.В.Каляда, Н.Г.Коробейщиков
Новый способ формирования углеродных нанотрубок

Полупроводниковые приборы и устройства

- 13.22 С.В.Морозов, В.Я.Алешкин, В.И.Гавриленко, А.А.Дубинов, **К.В.Маремьянин**, М.С.Жолудев, Б.Н.Звонков, А.А.Бирюков, С.М.Некоркин
Генерация разностной частоты в "двухчиповых" полупроводниковых лазерах GaAs/InGaAs/InGaP
- 13.23 **Г.Э.Шайблер**, В.В.Бакин, А.С.Ярошевич, С.Н.Косолобов, А.С.Терехов, А.Ю.Андреев, К.Ю.Телегин, А.А.Падалица, А.А.Мармалюк
"Фотонный перенос" даёт значительный вклад в диффузию неравновесных электронов в p-GaAs
- 13.24 **А.В.Вишняков**, В.С.Варавин, М.О.Гарифуллин, А.В.Придеин, В.Г.Ремесник, И.В.Сабинаина, Г.Ю.Сидоров
Исследование влияния постимплантационного отжига на ВАХ ИК фотодиодов на основе p-Cd_xHg_{1-x}Te
- 13.25 **В.П.Попов**
Квазибаллистический перенос в модели неоднородной зависимости транспортных свойств в нанометровых полевых транзисторах
- 13.26 **И.И.Ижнин**, А.В.Войцеховский, С.А.Дворецкий, Н.Н.Михайлов, Ю.Г.Сидоров, В.С.Варавин, К.Д.Мынбаев, М.Поцяск, Н.Х.Талипов
Конверсия типа проводимости при ионном травлении МЛЭ структур CdHgTe с варизонными защитными слоями
- 13.27 **П.Н.Дробот**
Осциллисторный RF-преобразователь
- 13.28 Л.П.Авакянц, **П.Ю.Боков**, И.С.Васильевский, Г.Б.Галиев, Е.А.Климов, А.В.Червяков
Спектроскопия фотоотражения дельта-легированных PHEMT-структур на основе AlGaAs/InGaAs/GaAs
- 13.29 Г.И.Айзенштат, М.А.Лелеков, И.И.Надреев, **И.Ф.Нам**, С.А.Рябков, О.П.Толбанов, А.В.Тяжев
Матричные арсенид галлиевые детекторы рентгеновских и гамма квантов

- 13.30 Е.Д.Васильева, В.В.Уелин, А.В.Феопентов, Б.С.Явич, П.Ю.Боков, П.В.Иванников, А.В.Чуяс, **А.Э.Юнович**
Светодиоды белого свечения на основе гетероструктур с квантовыми ямами InGaN/AlGaIn/GaN
- 13.31 **М.Д.Шарков**, К.Ю.Погребницкий, М.Е.Бойко, С.Г.Конников
Аппаратура и рентгеноспектральные методики нанодиагностики материалов: XAFS и МУРР
- 13.32 **В.М.Трухан**, В.Г.Федотов
Области практического применения материалов группы A^{II}B^V (A-Zn, Cd; B-P, As)
- 13.33 Г.Л.Курышев, **В.Г.Половинкин**
Расчет и оптимизация спектральных характеристик многослойных тонкопленочных структур в составе ФПУ
- 13.34 В.М.Базовкин, Н.А.Валишева, А.А.Гузев, В.М.Ефимов, А.П.Ковчавцев, **Г.Л.Курышев**, И.И.Ли, В.Г.Половинкин, А.С.Строганов
Универсальное линейчатое фотоприемное устройство на основе InAs МДП структур для систем тепlopеленгации
- 13.35 **Р.В.Лёвин**, С.В.Сорокина, В.П.Хвостиков, Б.В.Пушный
Получение гетероструктур на основе GaSb методом газофазной эпитаксии из МОС
- 13.36 С.В.Быткин, **Т.В.Критская**, Е.Г.Радин, В.И.Гончаров, В.Б.Колесник, Ю.И.Куницкий
Экспериментальное исследование характеристик тиристорov, изготовленных на SiGe при действии гамма-облучения
- 13.37 М.Д.Вилисова, В.П.Гермогенов, О.Ж.Казтаев, В.А.Новиков, **И.В.Пономарев**
Исследование распределения электрического поля в детекторных структурах на GaAs с помощью СЗМ
- 13.38 **В.М.Залётин**, М.С.Кузнецов, И.С.Лисицкий, И.П.Барков, И.М.Газизов, В.С.Хрунов
Кристаллы TiVg для детекторов радиации
- 13.39 Г.Л.Курышев, **А.Е.Настовьяк**, В.Г.Половинкин
Модель релаксации неравновесного обеднения в МДП фотоприёмниках
- 13.40 **Г.Ф.Карлова**, Т.Ю.Белополова
Исследование ионнолегированных структур с использованием технологии самосовмещения для создания датчиков магнитного поля с низким остаточным напряжением в n-GaAs
- 13.41 В.Г.Божков, **Н.А.Торхов**, И.В.Ивонин, В.А.Новиков
Механизм включения контакта металл-полупроводник с барьером Шоттки
- 13.42 А.В.Войцеховский, **Н.Х.Талипов**
Активация имплантированного бора и азота в гетероэпитаксиальных структурах Cd_xHg_{1-x}Te, выращенных методами ЖФЭ и МЛЭ, при низкотемпературном отжиге под анодным окислом
- 13.43 **В.Г.Кеслер**, В.А.Селезнёв, А.П.Ковчавцев, А.А.Гузев
Исследование поверхности InAs(111)A после химической обработки в насыщенном растворе HCl-изопропиловый спирт и отжигов в вакууме методами РФЭС и АСМ

Суббота, 3 октября

Секция 1	Секция 2
Широкозонные материалы 2	Полупроводниковые приборы и устройства 3
09:00-10:00, Конференц-зал Конгресс-центра "Рубин", Томск (Т1)	09:00-11:00, Конференц-зал ИОА СО РАН, Томск (Т2)
<p>6.4 И.И.Тартаковский Пикосекундная кинетика формирования электронно-дырочных слоев в широкозонных A_2B_6 гетероструктурах 2-го типа</p> <p>6.5 А.А.Лебедев, П.Л.Абрамов, С.Ю.Давыдов, С.П.Лебедев, Д.К.Нельсон, Б.С.Разбирин, Л.М.Сорокин Исследование спектров фото- и электролюминесценции квантовых ям в гетероструктурах 3C-SiC/6H-SiC</p> <p>6.6 Е.В.Богданова, Б.Я.Бер, А.А.Грешнов, А.Л.Закгейм, Г.Г.Зегря, Д.Ю.Казанцев, З.Н.Соколова, В.В.Уелин, А.Е.Черняков, Н.М.Шмидт, Е.Б.Якимов Механизмы падения внешней квантовой эффективности синих светодиодов на основе квантовых ям InGaN</p>	<p>13.16 М.В.Дорохин, О.В.Вихрова, Ю.А.Данилов, П.Б.Дёмина, Б.Н.Звонков, А.В.Кудрин, М.М.Прокофьева Ферромагнитные эмиттеры в светоизлучающих диодах на основе квантово-размерных гетероструктур InGaAs/GaAs</p> <p>13.17 Л.Л.Васильева, С.А.Волков, Д.Г.Есаев, М.А.Демьяненко, И.О.Кравченко, В.Н.Овсюк, Б.И.Фомин Термочувствительные слои оксидов ванадия для неохлаждаемых матричных микроболометрических приемников</p> <p>13.18 А.В.Антонов, Ю.Н.Дроздов, З.Ф.Красильник, К.Е.Кудрявцев, Д.Н.Лобанов, А.В.Новиков, С.В.Оболенский, М.В.Шалеев, Д.В.Шенгуров, В.Б.Шмагин, А.Н.Яблонский SiGe гетероструктуры с самоформирующимися nanoостровками для элементов кремниевой оптоэлектроники</p>
Двумерные системы 4	
10:00-11:00, Конференц-зал Конгресс-центра "Рубин", Томск (Т1)	
<p>4.16 В.М.Ковалев, А.В.Чаплик Эффекты экранирования и осцилляции Фриделя в наноструктурах с квантовыми ямами</p> <p>4.17 В.М.Муравьев, С.И.Губарев, А.А.Дремин, В.В.Козлов, И.В.Кукушкин Плазменные волны в двумерной электронной системе при периметрическом экранировании металлическим затвором и новый тип краевых плазменных возбуждений</p> <p>4.18 М.В.Якунин, С.М.Подгорных, Дж.Галисту, А.деВиссер, Ю.Г.Садофьев, Н.Н.Михайлов, С.А.Дворецкий Аномалии эволюции картины магнитных уровней и (псевдо)спиновых щелей с поворотом магнитного поля в квази-двумерных системах со значительным объемным g-фактором</p>	<p>13.19 В.К.Еремин, А.Г.Забродский, Е.М.Вербицкая Перспективы создания полупроводниковых трековых детекторов для экспериментов на коллайдерах с высокой светимостью</p> <p>13.20 И.Б.Чистохин, О.П.Пчеляков, Е.Г.Тишковский, В.И.Ободников, В.В.Максимов, А.А.Иванов, Е.И.Пинженин, E.Gramsch Кремниевые лавинные диоды для регистрации ядерных частиц</p> <p>13.21 Ю.В.Жиляев, Т.А.Орлова, Д.И.Микулик, Se.Nenonen, В.Н.Пантелеев, Н.К.Полетаев, С.Л.Смирнов, С.А.Сныткина, Л.М.Федоров Детекторы рентгеновского излучения на основе GaAs</p>

11:00 – 11:15 Перерыв

Органические полупроводники, молекулярные системы

11:15-12:05, Конференц-зал Конгресс-центра "Рубин", Томск (Т1)

Приглашенный доклад

10.1 А.Н.Алешин
Композиты полимер-неорганические наночастицы для оптоэлектроники

10.2 С.В.Новиков
Коррелированный энергетический беспорядок в органических стеклах и его влияние на прыжковый транспорт и инжекцию носителей заряда

Пленарное заседание

12:05-12:40, Конференц-зал Конгресс-центра "Рубин", Томск (Т1)

Пленарный доклад

2 И.Г.Неизвестный
Нанотехнологии в полупроводниковых сенсорах

12:40 - 14:00
Закрытие конференции
Награждение молодых ученых